

請求の範囲

- [請求項1] 接着剤残留物を除去するために用いられる洗浄剤組成物であって、第四級アンモニウム塩と、金属腐食抑制剤と、有機溶媒とを含み、上記金属腐食抑制剤が、炭素数7～40の脂肪族飽和炭化水素化合物モノカルボン酸、炭素数7～40の脂肪族飽和炭化水素化合物ジカルボン酸若しくはその酸無水物、炭素数7～40の脂肪族不飽和炭化水素化合物モノカルボン酸又は炭素数7～40の脂肪族不飽和炭化水素化合物ジカルボン酸若しくはその酸無水物からなることを特徴とする洗浄剤組成物。
- [請求項2] 上記金属腐食抑制剤が、炭素数7～40の脂肪族飽和炭化水素化合物モノカルボン酸、炭素数7～40の脂肪族飽和炭化水素化合物ジカルボン酸無水物又は炭素数7～40の脂肪族不飽和炭化水素化合物ジカルボン酸無水物を含む請求項1記載の洗浄剤組成物。
- [請求項3] 上記金属腐食抑制剤が、炭素数7～40の脂肪族飽和炭化水素化合物モノカルボン酸又は炭素数7～40の脂肪族不飽和炭化水素化合物ジカルボン酸無水物を含む請求項2記載の洗浄剤組成物。
- [請求項4] 上記金属腐食抑制剤が、ラウリン酸、ドデカン2酸又はオクタデセニルコハク酸無水物を含む請求項1記載の洗浄剤組成物。
- [請求項5] 上記第四級アンモニウム塩が、含ハロゲン第四級アンモニウム塩である請求項1～4のいずれか1項記載の洗浄剤組成物。
- [請求項6] 上記含ハロゲン第四級アンモニウム塩が、含フッ素第四級アンモニウム塩である請求項5記載の洗浄剤組成物。
- [請求項7] 上記含フッ素第四級アンモニウム塩が、フッ化テトラ（炭化水素）アンモニウムである請求項6記載の洗浄剤組成物。
- [請求項8] 上記フッ化テトラ（炭化水素）アンモニウムが、フッ化テトラメチルアンモニウム、フッ化テトラエチルアンモニウム、フッ化テトラプロピルアンモニウム及びフッ化テトラブチルアンモニウムからなる群から選ばれる少なくとも1種を含む請求項7記載の洗浄剤組成物。

- [請求項9] 上記接着剤残留物が、ヒドロシリル化反応により硬化する成分（A）を含む接着剤組成物から得られた接着層の接着剤残留物である請求項1～8のいずれか1項記載の洗浄剤組成物。
- [請求項10] バンプボールを有する半導体基板と、支持基板と、接着剤組成物から得られる接着層とを備える積層体を製造する第1工程、得られた積層体の半導体基板を加工する第2工程、加工後に半導体基板を剥離する第3工程、及び剥離した半導体基板上に残存する接着剤残留物を洗浄剤組成物により除去する第4工程を含む、加工された半導体基板の製造方法において、上記洗浄剤組成物として請求項1～9のいずれか1項記載の洗浄剤組成物を用いることを特徴とする、加工された半導体基板の製造方法。